

Der Weg ist frei fu?r noch kleinere Transistoren



Forschern am Fraunhofer-Institut fu?r Angewandte Festko?rperphysik IAF ist es gelungen, eine neue Art von Transistoren mit extrem hohen Grenzfrequenzen zu entwickeln: Metalloxidhalbleiter-HEMTs, kurz MOSHEMTs. Dafu?r haben sie die Schottky-Barriere des klassischen HEMTs durch ein Oxid ersetzt. Entstanden ist ein Transistor, der noch kleinere und leistungsfa?higere Bauteile erm?glicht und bereits eine Rekordfrequenz von 640 GHz erreicht hat. Diese Technologie soll die Elektronik der na?chsten Generation voranbringen. // Researchers at the Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics IAF have succeeded in developing a new type of transistor with extremely high cut-off frequencies: Metal Oxide Semiconductor HEMTs, MOSHEMTs for short. For this purpose they have replaced the Schottky barrier of the classical HEMT by an oxide. The result is a transistor that enables even smaller and more powerful components and has already reached a record frequency of 640 GHz. This technology is expected to advance next-generation electronics.

Rating: Not Rated Yet

Price

Price with discount: 3,18 €

3,18 €

Sales price without tax: 3,18 €

Tax amount:

[Ask a question about this product](#)